

2SD1661M

2SD1866

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコンダーリントントランジスタ
中電力増幅用/Medium Power Amp.
Epitaxial Planar NPN Silicon Darlington Transistors

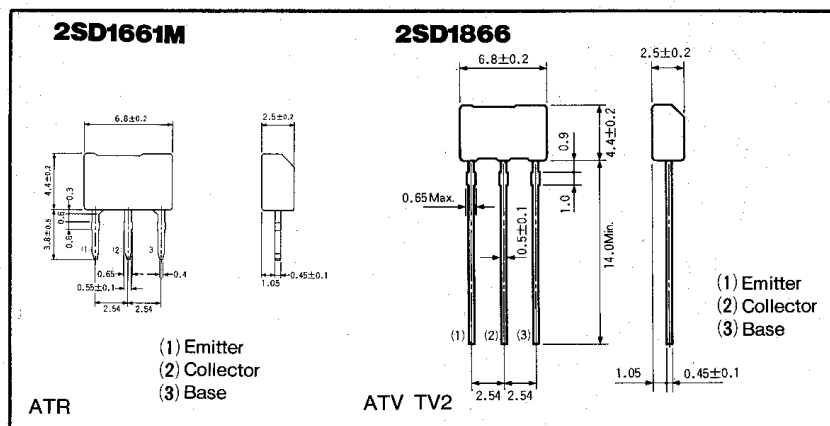
● 特長

- 1) コレクタ・ベース間に60Vのツェナーダイオードを内蔵。
- 2) サージに強い。
- 3) ダンパーダイオード内蔵。
- 4) ベース・エミッタ間に抵抗内蔵。

● Features

- 1) Zener diode of 60V is incorporated across collector and base.
- 2) Highly resistant to surge.
- 3) Damper diode is incorporated.
- 4) Built-in resistance between base and emitter.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit: mm)



注：ATVの外形仕様については、TV3/4/6タイプも用意しています(p.38参照)。

トランジスタ

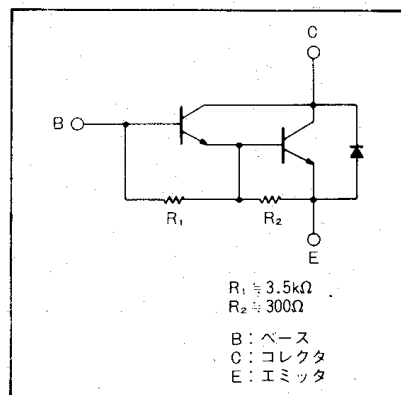
2SDタイプ

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	60±10	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	60±10	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	6	V
コレクタ電流	I _C	1.5	A
		3	A (Pulse)
コレクタ損失	P _C	1.0	W*
接合部温度	T _j	150	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-55~150	°C

*プリント基板：コレクタ部分の銅箔面積1cm²以上、厚み1.7mm

● 内部等価回路図



● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	50	—	70	V	I _C = 5mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CBO}	50	—	70	V	I _C = 50 μA
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	—	—	1.0	μA	V _{CB} = 40V
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	—	—	3	mA	V _{EB} = 5V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	—	1.5	V	I _C /I _B = 1A/1mA
直流電流増幅率	h _{FE}	1 000	—	10 000	—	V _{CE} /I _C = 2V/1A
出力容量	C _{ob}	—	25	—	pF	V _{CB} = 10V, I _E = 0A, f = 1MHz

● 標準品・準標準品一覧表

(◎: 標準品 ○: 準標準品)

Type	h _{FE}	包装名 記号	バルク		コンテナ		テーピング	
			1 000	4 000	C2	TV2	TV3	TV3
2SD1661M	1K~10K		◎	◎	—	—	—	—
2SD1866	1K~10K		—	—	○	○	—	—